

The 8th International Workshop on Beam Injection Assessment of Microstructures in Semiconductors June 11–14, 2006 (с. 899–907) (продолжение)

Borisov S.S., Zaitsev S.I., Grachev E.A.

Simulation of the fluctuations of energy and charge deposited during e -beam exposure 899

Nashchekin A.V., Baryshev S.V., Sokolov R.V., Usov O.A.

Cathodoluminescence studies of C_{60} fullerene-based films and nanostructures 901

Sharkov M.D., Pogrebitsky K.Ju., Konnikov S.G.

Method for Extracting of EXAFS Oscillation Function Based on the Variation Principle 904

● **Электронные и оптические свойства полупроводников**

Горкавенко Т.В., Зубкова С.М., Макара В.А., Русина Л.Н.

Температурная зависимость зонной структуры полупроводниковых соединений типа вюртцита: ZnS, ZnSe, ZnTe, CdTe 908

Осипов Е.Б., Осипова Н.А., Мокина М.Е., Цветкова С.Н., Канглиев С.Д.

Константы деформационного потенциала глубокого примесного центра в полупроводниках с анизотропной валентной зоной 917

Шалимова М.Б., Бесчасная Е.Г.

Коррекция метода вольт-амперных характеристик для определения плотности поверхностных состояний в системе германий-фторид редкоземельного элемента 920

Рогозин И.В.

Приготовление пленок ZnO:N методом радикало-лучевой геттерирующей эпитаксии 924

Алешкин В.Я., Востоков Н.В., Гапонова Д.М., Данильцев В.М., Дубинов А.А., Красильник З.Ф., Корятин А.И., Курицын Д.И., Пряхин Д.А., Шашкин В.И.

Пикосекундная кинетика фотоносителей в арсениде галлия с нанокластерами алюминия 929

Кудоярова В.Х., Козюхин С.А., Цэндин К.Д., Лебедев В.М.

Фотолюминесценция и состав аморфных пленок As_2Se_3 , модифицированных комплексным соединением $Er(thd)_3$. 934

● **Полупроводниковые структуры, границы раздела и поверхность**

Иванов П.А., Костина Л.С., Потапов А.С., Самсонова Т.П., Белякова Е.И., Аргунова Т.С., Грехов И.В.

Вольт-амперные характеристики изотипных переходов SiC–SiC, изготовленных методом прямого твердофазного срачивания 941

Биленко Д.И., Белобровая О.Я., Жаркова Э.А., Терин Д.В., Хасина Е.И.

Влияние давления атмосферного воздуха на токоперенос в структурах с окисленным пористым кремнием 945

● **Низкоразмерные системы**

Володин В.А., Ефремов М.Д., Якимов А.И., Михайлёв Г.Ю., Никифоров А.И., Двуреченский А.В.

Определение из данных спектроскопии комбинационного рассеяния света состава и деформаций в наноструктурах на основе Ge_xSi_{1-x} с учетом вклада гетерограницы . . . 950

Кондратенко С.В., Николенко А.С., Вакуленко О.В., Головинский С.Л., Козырев Ю.Н., Рубежанская М.Ю., Водяницкий А.И.

Продольная фотопроводимость гетероструктур Ge/Si с квантовыми точками Ge 955

Боднарь И.В., Гурин В.С., Соловей Н.П., Молочко А.П.

Формирование и оптические свойства наночастиц $CuInTe_2$ в силикатной матрице 959

● **Аморфные, стеклообразные, пористые, органические, микрокристаллические полупроводники, полупроводниковые композиты**

Ястребов С.Г., Иванов-Омский В.И.

Об аллотропном составе аморфного углерода 965

Воронцов А.С., Осминкина Л.А., Ткаченко А.Е., Константинова Е.А., Еленский В.Г., Тимошенко В.Ю., Кашкаров П.К.

Модификация свойств пористого кремния при адсорбции молекул йода 972

● **Физика полупроводниковых приборов**

Воронкова Г.М., Попов В.Д., Протопопов Г.А.

Уменьшение плотности ловушечных центров в оксиде кремния при радиационно-термической обработке 977

Болотов В.В., Пономарева И.В., Стенькин Ю.А., Кан В.Е.

Влияние адсорбции NO_2 на оптические и электрофизические свойства слоев пористого кремния 981

Камилов И.К., Алиев К.М., Алиев Б.Г., Ибрагимов Х.О., Абакарова Н.С.

Неустойчивость тока и N -образная вольт-амперная характеристика в кремниевом $p-i-n$ -диоде в магнитном поле 984

Зотеев А.В., Головань Л.А., Круткова Е.Ю., Лактунькин А.В., Мамичев Д.А., Кашкаров П.К., Тимошенко В.Ю., Астрова Е.В., Перова Т.С.

Усиление комбинационного рассеяния света в щелевых кремниевых структурах 989

Залесский В.Б., Рудь В.Ю., Гременок В.Ф., Рудь Ю.В., Леонова Т.Р., Кравченко А.В., Зарецкая Е.П., Тиванов М.С.

Бескадмиевые тонкопленочные гетерофотоэлементы $\text{Cu}(\text{In,Ga})\text{Se}_2/(\text{In}_2\text{S}_3)$: создание и свойства 992

Иванов А.М., Строкан Н.Б., Садохин А.В., Лебедев А.А.

Влияние низкотемпературного отжига на характеристики SiC-детекторов с введенными радиационными дефектами 998

Винокуров Д.А., Капитонов В.А., Лютецкий А.В., Пихтин Н.А., Слипченко С.О., Соколова З.Н., Станкевич А.Л., Хомялев М.А., Шамахов В.В., Борщёв К.С., Арсентьев И.Н., Тарасов И.С.

Насыщение ватт-амперных характеристик мощных лазеров ($\lambda = 1.0-1.8$ мкм) в импульсном режиме генерации . . . 1003

● **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Антонова И.В., Соотс Р.А., Селезнев В.А., Принц В.Я.

Электрическая пассивация поверхности кремния органическими монослоями 1-октадецена 1010

Заботнов С.В., Ежов А.А., Головань Л.А., Ластовкина М.А., Панов В.И., Тимошенко В.Ю., Кашкаров П.К.

Формирование наночастиц на поверхности кремния под действием фемтосекундных лазерных импульсов 1017

● **Персоналии**

Смирнов Леонид Степанович

(к 75-летию со дня рождения) 1021